

A.F., H.F. AND SWITCHING TRANSISTORS P-N-P NF-, HF- UND SCHALTTRANSISTOREN P-N-P

Type Typ	Maximum ratings ● Grenzdaten						$-I_{CBO}$ max	at bei	$-U_{CB}$	h_{21E} at bei	$-U_{CB}$	$-I_C$	f_T min	Case Gehäuse
	$-U_{CBO}$	$-U_{CER}^{1)}$	$-I_C$	$-U_{EBO}$	P_{tot}	θ_j								
	V	V $-U_{CEO}^{2)}$	mA	V	mW	°C								
KF423	250	250*	25	5	830	150	0,01	200	> 50	20	25	60	T16	
KF470	250	250*	30	5	2W ³⁾	150	0,01	200	> 50	20	25	60	T48	
KF517	40	30	500	5	800 2600 ²⁾	200	0,5	30	A: 35...120 B: 90...300 C: 60...160	10	10	50	T18	

¹⁾ $R_{BE} = \infty$

²⁾ With ideal cooling ● Mit idealer Kühlung

³⁾ $\theta_c \leq 110^\circ\text{C}$

R.F. TRANSISTORS N-P-N FOR SMALL TRANSMITTER TO 480 MHz HF-TRANSISTOREN N-P-N FÜR KLEINSENDER BIS 480 MHz

Type Typ	Maximum ratings ● Grenzdaten					G_p at bei	f	U_C	P_O	Case Gehäuse
	U_{CB}	U_{CE}	U_{BE}	I_E	P_C					
	V	V	V	A	W					
KF630D	36	25	3	0,4	5	16,5	80	12	0,5	T19
						10,5	160	12	0,5	
						7,0	240	12	0,5	
KF630S ¹⁾	30	25	3	0,4	5	6,0	146	13,2	1	T19
KF621	40	20	2	0,4	3,5	$10 \geq 9$	160	12	1	T19
KF622	55	30	3,5	0,4	5	4	470	12	0,4	T19
						$13 \geq 10$	400	28	1	

¹⁾ Pair of selected transistors ● Paar der ausgesuchten Transistoren.

R.F. TETRODE TRANSISTORS MOS WITH CHANNEL N FOR VHF AND UHF BAND HF-TETRODE-TRANSISTOREN MOS MIT KANAL N FÜR VHF- UND UHF-BAND

Type Typ	Maximum ratings ● Grenzdaten				U_{DS}	U_{G2S}	U_{G1S}	I_{DSS}	y_{21S}	f	G_{ps}	F	Case Gehäuse
	U_{DS}	I_D	$\pm I_{G1S}$	P_{DS}									
	V	mA	$\pm I_{G2S}$ mA	mW									
KF907	20	40	10	250	15	4	0	3...18	14 \geq 12	0,001 200 800	\geq 25 \geq 16	3 \leq 5	T50
					15	4	8						
					15	4							
					15	4							
KF910	20	50	10	300	12	4	0	6...40	20 \geq 16	0,001 200	25 \geq 22	2,5 \leq 4,5	T50
					12	4	16						
					12	4	16						

$\theta_a = -55^\circ\text{C} \dots +125^\circ\text{C}$.